Московский Физико-Технический Институт

Кафедра Общей физики

Лабораторная работа №3.3.4

Эффект Холла в полупроводниках.

Автор:

Глеб Уваркин 615 группа Преподаватель:

Андрей Александрович Заболотных





Цель работы:

Измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.

В работе используются:

Электромагнит с источником питания GPR, батарейка 1,5 B, амперметр, реостат, цифровой вольтметр B7-78/1, милливеберметр, образцы легированного германия.

1 Теоретическая часть

1.1 Дырки

Эффект Холла, возникающий в проводниках, происходит из-за наличия некоторого количества свободных электронов в зоне проводимости и такого же количества дырок в валентной зоне. Чтобы понять причину образования дырок, нужно рассмотреть дырочную проводимость.

Дырочную проводимость можно объяснить при помощи следующей аналогии: если представить ряд людей, сидящих в аудитории, где нет запасных стульев. Когда кто-нибудь из середины ряда хочет уйти, он перелезает через спинку стула в пустой ряд и уходит. Здесь пустой ряд — аналог зоны проводимости, а ушедшего человека можно сравнить со свободным электроном. Теперь представим, что ещё кто-то пришёл и хочет сесть. Из пустого ряда плохо видно, поэтому там он не садится. Вместо этого человек, сидящий возле свободного стула, пересаживается на него, вслед за ним это повторяют и все его соседи. Таким образом, пустое место как бы двигается к краю ряда. Когда это место окажется рядом с новым зрителем, он сможет сесть. В этом процессе каждый сидящий передвинулся вдоль ряда. Если бы зрители обладали отрицательным зарядом, такое движение было бы электрической проводимостью. Если вдобавок стулья заряжены положительно, то ненулевым суммарным зарядом будет обладать только свободное место. Это простая модель, показывающая как работает дырочная проводимость. Однако на самом деле, изза свойств кристаллической решётки, дырка не локализована в определённом месте, как описано выше, а размазана по области размером во много сотен элементарных ячеек.

1.2 Эффект Холла

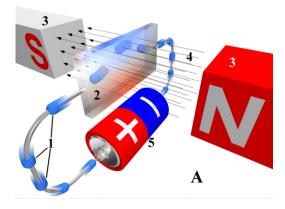


Рис. 1: Пример действия эффекта Холла на свободные заряды

<u>MIPT</u>.

Магнитного поле в проводнике действует на свободные электроны в зоне проводимости, поэтому между гранями наблюдается добавочная разность потенциалов, связанная с силой Лоренца.

$$F_{\text{JI}} = -eE - e\langle v \rangle \times B,$$

где e - абсолютная величина заряда электрона, ${m B}$ - индукция магнитного поля, ${m E}$ - напряженность электрического поля, $\langle v \rangle$ - средняя скорость заряда.

Из этого выражения получим разность потенциалов между двумя гранями:

$$U = -E_z l = -|\langle v \rangle|Bl \tag{1}$$

С этой возникшей разностью потенциалов и связан Эффект Холла.

Далее, если выразить ток:

$$I = ne|\langle \psi \rangle| la$$

И совместить его с 1, получим ЭДС Холла:

$$\mathcal{E}_x = U = -\frac{IB}{nea} = -R_x \cdot \frac{IB}{a},\tag{2}$$

где $R_x = \frac{1}{ne}$ называется постоянной Холла.

<u>MIPT</u>.

2 Установка и параметры измерения

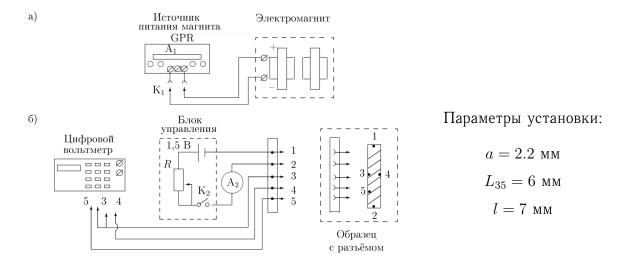


Рис. 2: Схема установки для измерения эффекта Холла в полупроводниках

В нашей установке вдоль длинной стороны образца будет течь ток, величина которого регулируется реостатом R_2 . Так как он помещен в электромагнит, между точками $3\ u\ 4$ будет возникать разность потенциалов U_{34} , которую мы будем измерять.

Однако между точками 3 u 4 будет возникать некоторое дополнительное падение напряжения U_0 , так как эти точки оказываются не на одной эквипотенциали. Исключить это влияние можно с помощью изменения направления магнитного поля: в одном случае $U_{34} = U_0 - \mathcal{E}_x$, в другом $U_{34} = U_0 - \mathcal{E}_x$. Тогда с помощью полуразности избавимся от U_0 в наших измерениях.



Рис. 3: Эффект Холла при различных направлениях магнитного поля и тока через образец

<u>MIPT</u>

3 Обработка результатов.

3.1 Градуировка электромагнита.

С помощью милливеберметра исследуем зависимость индукции B магнитного поля в зазоре электромагнита от тока через обмотки магнита. Запишем результат в таблицу (1).

Таблица 1: Зависимость $B = f(I_M)$.

J_M , A	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
$J_M,\; { m A} \ B,\; { m MT}$ л	0.28	2.22	4.58	6.67	8.61	9.86	10.83	11.53

Построим график этой зависимости:

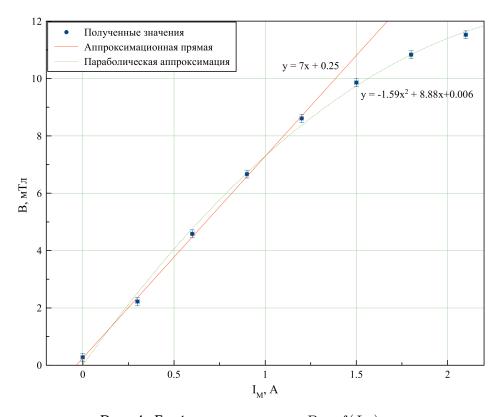


Рис. 4: График зависимости $B = f(I_M)$.

3.2 Измерение ЭДС Холла.

Снимем зависимость ЭДС Холла от величины магнитной индукции B при разных значениях тока I через образец. Построим на одном листе семейство характеристик $\mathcal{E}_x = f(B)$.

<u>MIPT</u>

Таблица 2: Зависимость ЭДС Холла от магнитного поля

I, м A	U_0 , мВ	$egin{array}{c c} I_M, & A \\ B, & MTЛ \end{array}$	0 27.8	0.3 222.2	0.6 458.3	0.9 666.7	1.2 861.1	1.5 986.1	1.8 1083.3	2.1 1152.8
0.3	0.066	U , MB \mathcal{E}_x , MB	0.066	0.095	-0.122 0.056	0.145 0.079	0.164 0.098	0.178 0.112	0.185 0.119	0.192 0.126
0.4	0.087	U , MB \mathcal{E}_x , MB	0.090	0.126 0.039	0.162 0.075	0.194 0.107	0.218 0.131	0.236 0.149	0.247 0.160	0.255 0.168
0.5	0.108	U , MB \mathcal{E}_x , MB	0.113 0.005	0.159 0.051	0.202 0.094	0.243 0.135	0.274 0.166	0.295 0.187	0.308 0.200	0.318 0.210
0.6	0.130	U , мВ \mathcal{E}_x , мВ	0.135 0.005	0.188	0.245 0.115	0.289 0.159	0.328 0.198	0.355 0.225	0.371 0.241	
0.7	0.153	U , мВ \mathcal{E}_x , мВ	0.159 0.006	0.221 0.068	0.285 0.132	0.340 0.187	0.385 0.232	0.415 0.262	0.434 0.281	
0.8	0.174	U , мВ \mathcal{E}_x , мВ	0.180	0.253 0.079	0.325	0.395	0.443 0.269	0.473 0.299	0.494 0.320	
0.9	0.196	U , мВ \mathcal{E}_x , мВ	0.204 0.008	0.288	0.365 0.189	0.435 0.239	0.494 0.298	0.532 0.336	0.556	
1.0	0.218	U , мВ \mathcal{E}_x , мВ	0.227 0.009	0.318	0.408 0.190	0.485 0.267	0.549 0.331	0.592 0.374	0.619 0.401	
1.0	0.220	$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	0.212	0.119	0.039	-0.033 -0.253	-0.088 -0.308	-0.127 -0.347	-0.150 -0.370	

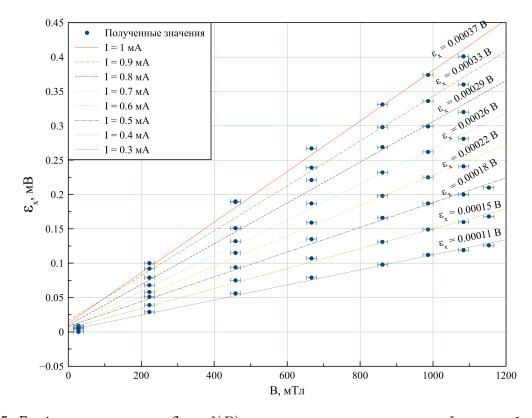


Рис. 5: График зависимости $\mathcal{E}_x = f(B)$ при разных значениях тока I через образец.

С помощью метода МНК определим угловые коэффициенты $K(I)=\Delta \mathcal{E}/\Delta B$ полученных прямых. Построим график K=f(I).

Таблица 3: Зависимость углового коэффициента от силы тока.

I, мА K , мВ/Тл	0.3	0.4 0.15	0.5 0.18	0.6 0.22	0.7 0.26	0.8 0.29	0.9 0.33	1 0.37
σ_K , мВ/Тл σ_I , мА	0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.009 0.012 0.009 0.01							

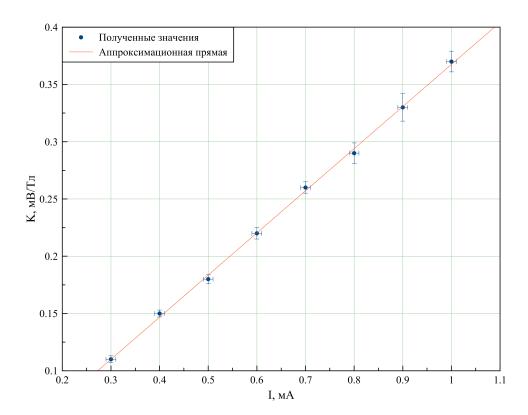


Рис. 6: График K = f(I).

Рассчитаем угловой коэффициент прямой с помощью МНК:

$$k = \frac{\langle K \cdot I \rangle - \langle K \rangle \langle I \rangle}{\langle I^2 \rangle - \langle I \rangle^2} \simeq 0.368 \frac{B}{T_{\pi} \cdot A}$$

$$\sigma_k = \frac{1}{\sqrt{8}} \sqrt{\frac{\langle K^2 \rangle - \langle K \rangle^2}{\langle I^2 \rangle - \langle I \rangle^2} - k^2} \simeq 0.004 \,\, \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{Ta} \cdot \mathrm{A}}$$

Из формулы (2) посчитаем постоянную Холла:

$$R_x = -\frac{\mathcal{E}_x}{IB} \cdot a = -k \cdot a = -(8.1 \pm 0.1) \cdot 10^{-4} \text{ м}^3/\text{K}$$
л.

Рассчитаем концентрацию n носителей тока в образце:

$$n = \frac{1}{R_{\pi}e} \simeq (7.7 \pm 0.1) \cdot 10^{21} \text{ 1/m}^3$$

Рассчитаем удельную проводимость σ германия с помощью $U_{35}=2.56$ мВ:

$$\sigma = \frac{IL_{35}}{U_{35}al} \simeq 152 \pm 3 \; (\mathrm{Om} \cdot \mathrm{m})^{-1}$$

Вычислим подвижность b носителей тока:

$$b = \frac{\sigma}{en} \simeq (1232 \pm 27) \; \frac{\text{cm}^2}{\text{B} \cdot \text{c}} \; ()$$

Запишем результаты расчётов в таблицу:

Таблица 4: Итоговые значения.

$R_x \pm \Delta R_x$, $10^{-4} \text{ м}^3/\text{K}$ л	Знак носителя	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$\begin{array}{ c c c } b \pm \Delta b, \\ 10^4 \text{ cm}^2/(\text{B} \cdot \text{c}) \end{array}$
-8.1 ± 0.1	-	7.7 ± 0.1	152 ± 3	1232 ± 27

4 Вывод.

В данной лабораторной работе был изучен эффект Холла, определены подвижность и концентрация носителей тока, а также их знак в легированном германии.